


Lithography-100 型紫外光刻机操作规程

一 开机准备




1. 刷卡开机。
2. 确定光刻机总电源插头插在配电插座上，开启真空泵，检查真空表显示读数是否正常。
3. 开启电脑、设备电源。


二 上掩膜、上片



1. 检查掩模气管是否插好。
2. 放上掩模，将掩模与掩模架上四个定位钉靠紧（注意掩模的正反面），按下“MASK”按钮将掩模吸到掩模架上（如漏气，检查气管和“掩模”按钮是否漏气，或者将掩模表面和掩模架安装面擦干净）。




3. 测量样品的大致厚度并在软件中设置 。






4. 拉出样品托盘，将样品放在承片台上，并保证两者的中心大致重合（硅片的切边方向），然后将托盘推回原位。

5. 如不需对准则直接按“exposure”键 ，系统会自动完成上升、调平，待样品上升至曝光位置后，按下“wafer”按钮吸住样片，然后点击“上升”按钮 （可视具体工艺情况而定），密着调整结束后设置曝光时间  并点

击“确认”按钮 ，确认曝光时间写入后点击“Start”按钮  按钮

开始曝光，待曝光时间读秒  结束后，点击 Load 按钮 ，软件弹窗提示 Z 轴电机回到初始位置后拉出硅片托盘，取出曝光后的样片。

6. 需要对准的曝光方式：点击“FOCUS”按钮 ，电机会带动样品托盘上升并完成自动调平，待硅片托盘上升至预定位置后，按下 wafer 按钮吸住样片，此时电脑屏幕上能同时看清楚样片及掩模板上的图形，通过调节 X、Y 及旋转手轮进行对准，对准结束后点击“exposure”键 ，待样品上升至曝光位置后，点击“上升”按钮 （可视具体工艺情况而定），密着调节结

束后设置曝光时间  并点击“确认”按钮 ，确认曝光时间写入后
点击“Start”  按钮开始曝光，待曝光时间读秒  结束后，点
击 Load 按钮 ，软件弹窗提示 Z 轴电机回到初始位置后拉出硅片托盘，
取出曝光后的样片。

三 实验结束

关闭电脑、设备电源，刷卡下机。